



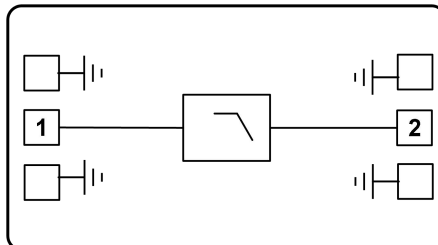
主要特点

通带频率: DC – 8 GHz
通带损耗: 2.0 dB @ 8 GHz
阻带抑制: 20 dB @ 9.8 GHz
40 dB @ 10.4 GHz
回波损耗: 20 dB
芯片尺寸: 1.0 × 0.75 × 0.1 mm³

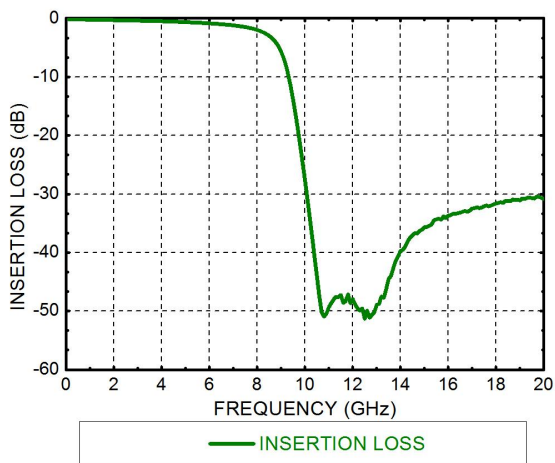
性能指标 ($T_A = +25^{\circ}\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 8			GHz
插入损耗		2.0		dB
阻带抑制 @ 10.2 – 20 GHz		35		dB
回波损耗		20		dB

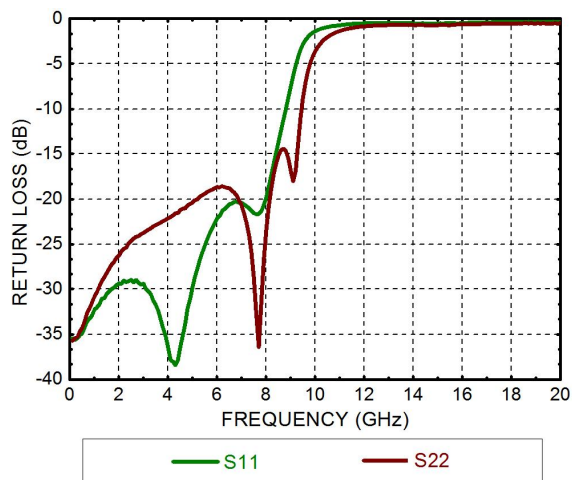
功能框图



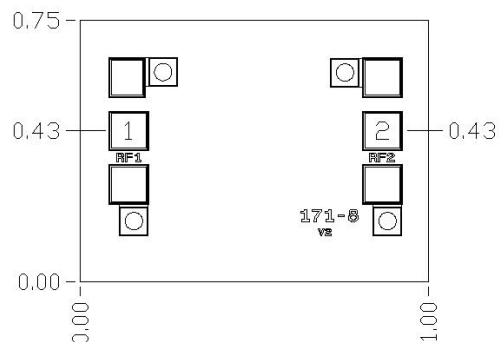
插入损耗



回波损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150 °C
工作温度	-55 ~ +85 °C